ナノスケール物性研究部門

Division of Nanoscale Science

ナノスケール物性研究部門では、原子レベルで整えられた物質表面・界面やナノ構造、リソグラフィにより緻密に制御されたナノ伝導領域などを舞台として、コヒーレンスに伴う量子現象や対称性の破れに伴い出現する特異な物性など、バルクでは見られない現象の探求を目指して研究を推進している。超薄膜成長技術、極微細加工技術、表面評価手法、プローブ顕微鏡による局所測定技術など、特色あるナノ構築・評価手法を統合的に駆使し、原子・分子レベルから無限系である量子輸送まで幅広い時空間スケールにおける物理・化学現象を対象とした研究を進めている。

研究テーマの一部を以下に示す。

- 物質の人工微細構造や複合界面において展開される量子・スピン輸送
- プローブ顕微鏡による局所電子状態・磁気特性や伝導 現象の研究
- 表面化学反応等のミクロな動的過程の研究、およびこれを利用した新物質の創成
- 各種超薄膜のエピタキシャル成長と機能物性開拓

In Division of Nanoscale Science, we aim to explore, on atomically prepared surfaces and interfaces of materials, nanostructures, and precisely controlled nanoscale regions confined by lithography, unique phenomena that cannot be seen in the bulk, such as quantum phenomena associated with the electron/spin coherence and materials' properties induced by the symmetry breaking. We are conducting researches on physical and chemical phenomena in a wide range of space and time scales, from the atomic and molecular levels to quantum transport in infinite systems, by making full use of unique nano-fabrication and characterization techniques, such as ultra-thin film growth, ultra-fine lithography, surface characterization, and local measurements using probe microscopy.

Some of the research themes are as follows.

- Quantum and spin transport in artificial nanoscale and hybrid systems
- Local electronic and magnetic states and transport at solid surfaces by scanning probe microscopes
- Microscopic analysis of dynamical processes such as chemical reaction at surfaces, and creation of new material phases
- Epitaxial growth of ultra-thin films and device applications

部門主任 長谷川 幸雄 Leader HASEGAWA, Yukio

勝本研究室

Katsumoto Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 量子電荷・スピン輸送現象 Quantum transport in charge and spin freedoms
- 2 量子構造を用いた多体効果の研究 Study of many-body effects in quantum structures
- 3 異対称性ハイブリッド構造に生じる物理現象 Physics at interfaces between the phases with different symmetries
- 4 量子ホール効果 Quantum Hall effect







助教 中村 壮智 Research Associate NAKAMURA, Taketomo



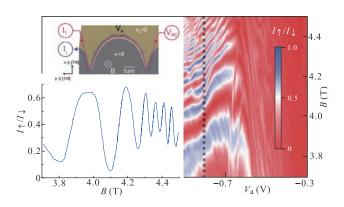
助教 遠藤 彰 Research Associate ENDO, Akira

半導体や金属の超薄膜成長技術、これらを微細加工する技術を用いて、量子井戸、細線、ドットなどのナノ構造中の量子効果、多体効果、強磁場中2次元電子系に現れる量子ホール効果を調べている。電子スピン、核スピンの織りなすスピン現象、非平衡・非断熱な量子遷移に伴う物理現象の研究を行なっている。

量子輸送現象をスピン自由度に広げる研究として、ナノ構造とスピン軌道相互作用を組み合わせる試みを行っている。ナノ構造を使い、空間反転対称性を破り局所的な軌道角運動量を導入することで、新しいタイプのスピン軌道相互作用を発生させることができる。一例が、量子ホール強磁性エッジ状態の屈曲を用いた非断熱スピン操作である。この系では、エッジ状態(軌道自由度)とスピン自由度が量子エンタングルしており、軌道操作とスピン操作の利点を実際上、同じ自由度に適用できる。非断熱スピン回転を伴う電流による超伝導制御など、新奇デバイスへの応用も期待される。

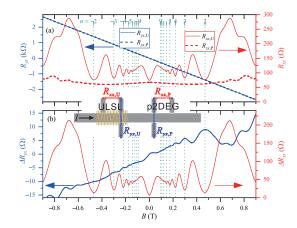
With the epitaxial growth of semiconductor and metallic films and nanofabrication techniques, we study quantum effects in low dimensional systems like quantum dots, wires and wells. Our research also spans some applications of the physics of electron and nuclear spins for so-called spintronics.

To expand the concept of quantum transport to spin degree of freedom, we have tried to create spin currents in quantum structures. The nanostructures enable us to introduce new types of spin-orbit interaction by breaking the spatial inversion symmetry and creating a local orbital angular momentum. An example is the non-adiabatic unitary operation on electron spins in quantum Hall ferromagnetic edge states. Because the spin freedom and the edge states (orbital freedom) are maximally entangled in this system, the spin and the orbital operations can be utilized equivalently. Similar non-adiabatic spin rotation by the normal current can be applied to control superconductivity in a novel device.



スピン偏極量子ホールエッジ状態を使ったビームスプリッタ。左上:電極配置。 左下:このビームスプリッタを使った量子干渉計出力の磁場依存性。右:同出 力のゲート電圧および磁場に対するカラープロット。

Beam splitter of spin-polarized quantum Hall edge states. Upper left: Configuration of gate electrodes. Lower left: Output of an interferometer which utilizes the beam splitter, as a function of magnetic field. Right: Color plot of the interferometer output on the plane of gate voltage and magnetic field.



(a) 1次元周期的ポテンシャル変調の有る場合(実線)、無い場合(破線)の2次元電子系のホール抵抗 R_{yx} と磁気抵抗 R_{xx} 。(b) R_{yx} と R_{xx} の変調による増分。 R_{yx} にも整合性振動が観測されている。

(a) Hall resistance R_{yx} (left axis) and magnetoresistance R_{xx} (right axis) of a two-dimensional electron gas with (solid line) and without (dashed line) the unidirectional periodic potential modulation. (b) Increment in R_{yx} and R_{xx} attributable to the modulation. Commensurability oscillations are clearly observed also in R_{yx} .



大谷研究室

Otani Group

研究テーマ Research Subjects

- トポロジカルスピントロニクス Topological spintronics
- 2 分子スピントロニクス Molecular spintronics
- 3 磁気スピンホール効果の発現機構の解明と機能性の開拓 Elucidation of the mechanism of the magnetic spin Hall effect and development of functionality
- 4 磁気弾性強結合による高効率スピン流生成 Efficient pure spin current generation by magnon-phonon coupling





助教 一色 弘成 Research Associate ISSHIKI, Hironari

教授 大谷 義近 Professor OTANI, Yoshichika

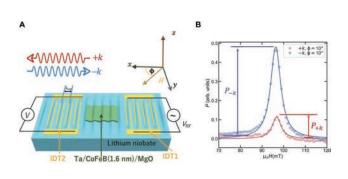
専攻 Course

新領域物質系

Adv. Mat., Frontier Sci.

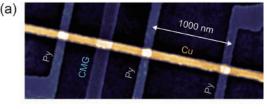
20世紀末に登場した「スピン流」の概念は、電流とスピン流を結びつけて効果的に利用する学理を体系化した。その結果、スピントロニクス研究は、電荷・スピン・フォノン・フォトン・マグノン等の準粒子が、固体中のスピンを媒介として、相互に変換される「スピン変換科学」として発展した。最近では、さらにこのスピン変換科学は、準粒子が結合したマグノンポーラロンなどの新奇準粒子状態を生成する強結合スピントロニクスとして新展開している。これらのスピンを媒介とする変換・結合現象は、比較的単純な接合界面近傍のナノスケール領域で生じることが多く、優れた汎用性と応用性を持っている。我々の研究室では基礎量子物性の観点から、スピンを媒介した新奇な準粒子変換や結合の開拓と発現機構の解明に取り組んでいる。さらに微細加工技術を駆使して、開拓した準粒子変換・結合を利用したスピン変換素子の研究開発を行っている。

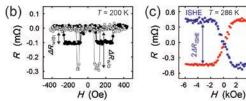
The concept of "spin current", which appeared at the end of the 20th century, established the principle of effectively using electric and spin currents. Thereby, spintronics research has evolved as a "spin conversion science" in which quasiparticles such as electric charges, spins, phonons, photons, and magnons are converted to each other through spins in solids. More recently, this spin conversion science has evolved into strong coupling spintronics, producing novel coupled quasiparticles, such as magnetic polarons. Since these spin-mediated conversion/coupling phenomena often occur in the nanoscale region near the relatively simple junction interface, they have excellent versatility and applicability. From the viewpoint of fundamental solid-state physics, our laboratory is developing novel quasiparticle conversions and coupling mediated by spins and elucidating their mechanisms. We also research and develop nanoscale spin conversion/coupling devices based on the quasiparticle conversion and coupling that we have elucidated using microfabrication technology.



Ta / CoFeB / MgO における磁気弾性波の非相反伝搬。(A)ギガヘルツ周波数で表面弾性波(SAW)を FM 層と結合するデバイスの模式図。(B)SAW 波数 + k および + k におけるスピン波共鳴条件付近の表面弾性波の減衰 + k + k

Nonreciprocal propagation of magnetoacoustic waves in Ta/CoFeB/MgO. (A) Device schematics of SAWs coupling to an FM layer at gigahertz frequencies. (B) Attenuation of acoustic waves, $P_{\pm k}$, near a spin-wave resonance condition for SAW numbers $\pm k$ and $\pm k$.





Weyl 強磁性体 Co₂MnGa の巨大スピンホール効果。(A) 非局所配置法測定素子の SEM 像。(B)Co₂MnGa 細線の有無に対応した非局所スピンバルブ信号。(C)Co₂MnGa のスピンホール効果と逆スピンホール効果の信号。

Giant spin Hall effect of a Weyl ferromagnet Co₂MnGa. (a) SEM image of a non-local spin valve structure. (b) The non-local spin valve signals with and w/o Co₂MnGa wire. (c) The signals of spin Hall effect and it's inverse of Co₂MnGa.



 $https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/otani_group.html$

長谷川研究室

Hasegawa Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 低温 STM による特異な超伝導 / トポロジカル物性の探索 Exploration of peculiar superconducting / topological states using lowtemperature STM
- 2 マイクロ波導入スピン偏極 STM によるナノスケール磁気共鳴 とスピンダイナミクス
 - Nanoscale detection of magnetic resonances and spin dynamics by microwave-assisted spin-polarized STM $\,$
- 3 スピン偏極走査ポテンショメトリによるスピン流の実空間計測 Real-space distribution of spin currents by spin-polarized scanning tunneling potentiometry
- 4 データ科学支援による高効率局所電子状態計測 Effective collection of local density of states with an assist of data science





明教 土即 特代 Research Associate HAZE, Masahiro

教授 長谷川 幸雄
Professor HASEGAWA, Yukio

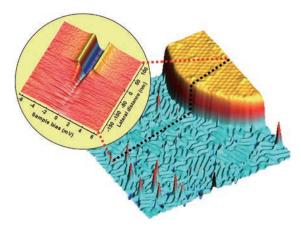
專攻 Course 工学系物理工学 App. Phys., Eng.

走査トンネル顕微鏡(STM)は、その像を通じて表面の原子構造を明らかにするのみならず、トンネル分光測定によりサブナノ領域での電子状態に関する知見を与え、さらにはスピン偏極(SP-)STMによる局所磁気特性や表面スピン構造を引き出すことができる。

長谷川研究室では、極低温強磁場下で動作するSTM装置を用いて、表面超伝導など反転対称性の破れた二次元系での超伝導特性、磁性体との近接効果により誘起される特異な超伝導・トポロジカル状態の観測を試みている。また、SP-STMによる磁性薄膜でのスピンスパイラルなど特異な局所磁気構造観察、スピン偏極局所ポテンショメトリによるスピン流計測、さらにはマイクロ波導入による磁気共鳴検出を通じた局所スピンダイナミクスの研究等も推進しており、プローブ顕微鏡の新たな計測手法を開発することにも取り組んでいる。

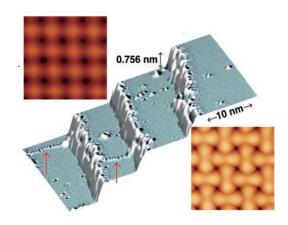
Scanning tunneling microscopy (STM) reveals not only atomic structure of surfaces but also electronic states of sub-nanometer areas by tunneling spectroscopy. With a function of spin-polarized (SP-) STM, the microscope also provides local magnetic properties and surface spin structures, and with inelastic tunneling spectroscopy (IETS), various excitation energies can be extracted.

In Hasegawa-lab., by using STMs operated in ultralow temperature and high magnetic field, peculiar local superconducting and topological states that are found e.g. at surfaces, where inversion symmetry is broken, and in the proximity with ferromagnetic and topological materials, have been explored. We have also studied local magnetic properties of nano magnets, peculiar spin-spiral structures, and energy dispersion of surface magnons using SP-STM and SP-IETS. We have also explored unique functionality of the probe microscopy; recent examples include the investigation of local spin dynamics through the detection of magnetic resonances using microwave-assisted SP-STM, spin current detection using SP-scanning tunneling potentiometry, and efficient collection of local density of states based on data-driven science.



超伝導金属界面での近接効果。単原子層 Pb(水色、金属相) と Pb 薄膜 (黄色、超伝導相) の界面でのトンネル分光から、超伝導特性が界面から約 40nm にわたって染み出している様子が観察される。

Proximity effect at superconductor/metal interface. Tunneling spectra taken around an interface between 1ML-Pb layer on Si (blue, normal metal) and a Pb thin film (yellow, superconductor) indicate the penetration of superconductivity into the metal layer with a decay length of 40 nm.



重い電子系物質 CeColns で観測された表面軌道秩序。Co 原子が正方配列した面 (中央、左上図)で、探針を近づけて STM 像 (右下図)を撮ると、ダンベル状の d 軌道の秩序配列状態が観察される。

Surface-induced orbital ordered states observed on a heavy-fermion material CeCoIn₅. In STM images taken on a Co-terminated surface in standard conditions, round-shaped Co atoms are observed (center and upper- left images). In STM images taken in closer distances (lower-right) we observed an ordered phase of dumbbell-shaped d-orbitals.



リップマー研究室

Lippmaa Group

研究テーマ Research Subjects

- 1 パルスレーザー堆積法による酸化物薄膜そしてヘテロ構造の 作製
 - Growth of thin oxide films and heterostructures by pulsed laser deposition $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right) +\left(1\right) \left(1\right) \left(1\right) +\left(1\right) \left(1$
- 2 水分解光電極反応の高効率化に向けた酸化物半導体材料の開発
 - Development of oxide photoelectrode materials for photocatalytic water splitting
- 3 酸化物ナノ構造またはナノコンポジット薄膜の合成 Synthesis of nanostructures and nanocomposite thin films
- 4 新規な有機ー無機界面の創出 Development of novel organic – inorganic interfaces





助教 森 泰蔵 Research Associate MORI, Taizo

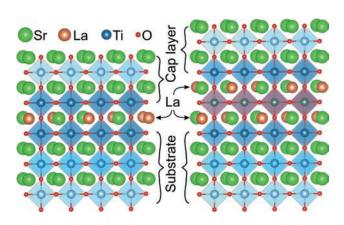
教授 リップマー ミック Professor LIPPMAA, Mikk

専攻 Course 新領域物質系

Adv. Mat., Frontier Sci.

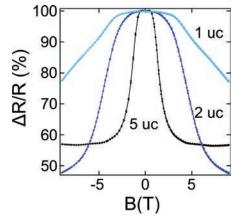
分子線エピタキシー法を用いて原子的に平滑な酸化物を形成することで、界面における特異な電気・磁気特性を観測できる。たとえば、デルタドープされた界面において二次元層間に閉じ込められたキャリア輸送特性を明らかにした。左図は、SrTiO3上に単層もしくは二層のLaTiO3層を成長させた後、さらにSrTiO3を堆積させ形成したSrTiO3/LaOへテロ構造である。各La層により供与された余剰電子のいくつかは、電荷移動を介して隣接したSrTiO3層へドープされる。このへテロ構造内では、一部の電子は局在化したり、金属的量子井戸を形成したり、基板に深部に広がったりと、多数の電子分布を形成する。表面空乏層や静電ゲーティングを活用しドープ層におけるLaの原子数を調節することで、電子分布のなす相対的な度合いを調整でき、それに伴い磁気輸送特性が明確な変化した。右図に示すように、キャリア数が変化すると面内磁気抵抗の変動が観察される。

The ability to grow atomically flat oxide thin films by laser molecular beam epitaxy allows us to study the transport behavior of carriers accumulated in two-dimensional layers at delta-doped interfaces. Left figure shows examples of such heterostructures where a single or double layer of LaTiO $_3$ was grown on a SrTiO $_3$ and capped with another SrTiO $_3$ layer. Each La atom donates an extra electron, some of which will dope the adjacent SrTiO3 layers by charge transfer. We find that multiple electron populations form in this structure, with some electrons localized at the interface, some forming a metallic quantum well, and some spreading deep into the substrate. The relative sizes of these different populations can be tuned by adjusting the total La number in the doping layer, by utilizing surface depletion, or using electrostatic gating. We can observe distinct changes in the magnetotransport behavior when the relative electron population sizes change, as illustrated in right figure, which shows the variation of in-plane magnetoresistance when the carrier number is changed.



La, Sr デルタドープによる形成された SrTiO $_3$ ヘテロ構造。チタン格子間にある (La,Sr)O 層の数によりドープされるキャリア数が制御される。

Delta-doped SrTiO₃ heterostructures where the number of doped carriers is controlled by the number of (La,Sr)O layers in the titanate lattice.



SrTiO₃/LaO ヘテロ構造の面内磁場抵抗。磁場を電流方向に対して平行に印加し 測定した。面内磁気抵抗がチタン格子間の原子層 LaO の層数 (1, 2, 5) により変 動する。

In-plane magnetoresistance, measured with the magnetic field parallel to the current flow, for heterostructures doped by 1, 2, or 5 LaO atomic layers in the titanate lattice.



バツィル研究室 Batzill Group



外国人客員教授 バツィル マティアス
Visiting Professor BATZILL, Matthias

2次元(2D)材料は、面内に共有結合を持ち、面直方向には化学結合を持たない。分子線エピタキシーでこのような超薄膜を成長させることができれば、弱い層間相互作用や近接効果によってのみ特性が制御される 2D 材料のヘテロ構造が構築可能である。また、2次元材料の端などの格子不整合部位では、トリビアルあるいはトポロジカルなエッジ状態を示すことがある。さらに、点欠陥や不純物ドーパントを用いて、2D 材料に新たな機能を導入することもできる。

我々の研究では、超伝導から半導体、種々の磁気状態まで幅広い特性を持つ2次元材料として、遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)に注目する。これらのヘテロ構造の作製に成功すれば、ナノスケールでの近接効果を実現する構成要素となりうる。走査トンネル顕微鏡/分光は、層間相互作用・異種材料との近接効果・局所的な格子変化による状態変化を調べるのに適した手法であり、その活用が期待される。

Two-dimensional (2D) materials exhibit covalent bonding within a molecular plane and have no unsaturated chemical bonds normal to that plane. The ability to grow these extended ultrathin sheets by molecular beam epitaxy (MBE), in principle, allows an assembly of heterostructures of dissimilar 2D materials whose properties are altered only through weak interlayer interactions or proximity effects. In addition, lattice discontinuities, for example, at edges of 2D materials may exhibit trivial or topological edge states. Point defects or impurity dopants may also be used to introduce new functionalities into 2D materials.

In our studies we focus on transition metal dichalcogenides (TMDs) as a broad family of 2D materials that span a large range of properties from super- to semi-conducting and various magnetic states. These materials can be thought of as a set of building blocks that if successfully prepared in heterostructures enables the study of nanoscale proximity effects. Scanning tunneling microscopy/spectroscopy are preferred tools to investigate local modifications in TMDs due to interlayer interactions, proximity with dissimilar materials, or local lattice modifications.